

Автоматизация процесса диагностики РЭА на основе метода эвристической классификации. *В. Е. Трофимов*
 Исследование MOSFET-транзисторов в различных герметичных корпусах для поверхностного монтажа. *И. И. Рубцевич, Л. П. Ануфриев, А. Ф. Керенцев*
 Температурные изоляторы для фидера сечением 70/30 мм. *Е. В. Кирюкова*
 Исследование диагностических признаков в статистической диагностике изделий методом низкоскоростного удара. *В. С. Еременко, В. М. Мокийчук*
 Технологические приемы улучшения теплового режима выращивания кристаллов GaAs методом Чохральского. *Г. П. Ковтун, А. И. Кравченко, А. И. Кондрик, А. П. Щербань*
 Измерительный комплекс для определения фотоэлектрических параметров приемников излучения. *А. А. Ащеулов, А. Х. Дунаенко, В. Д. Фотий*

Материалы электроники

Деграционные превращения в топологически разупорядоченных твердых телах: 2. Мономолекулярная модель кинетики. *В. А. Балицкая, Н. М. Вакив, О. И. Шпотюк*

4 Термоэлектрические свойства сплавов системы $TlInTe_2-PbYbTe_2$. *М. М. Зарбашиев, Н. Ф. Гахраманов, Н. С. Сардарова, Г. А. Гейдарова* 2
 5 Выбор полупроводникового материала для детекторов гамма-излучения. *А. С. Абызов, В. М. Ажажа, Л. Н. Давыдов, Г. П. Ковтун, В. Е. Кутний, А. В. Рыбка* 3
 5 Полупроводниковые гетеропереходы оксид—InSe(GaSe) для фотоэлектрических анализаторов поляризованного излучения. *З. Д. Ковалюк, В. Н. Катеринчук* 3
 5 Деграционные превращения в топологически разупорядоченных твердых телах: 3. Бимолекулярная кинетика затухания радиационных эффектов в ХСП. *Н. М. Вакив*
 6 Диэлектрическая релаксация Коул-Коула. *В. В. Новиков, О. А. Комкова* 5
 6 Квантовый выход межзонной излучательной рекомбинации в кристаллах CdHgTe. *А. И. Власенко, З. К. Власенко* 6
 6 Моделирование свойств CdZnTe и параметров детекторов γ -излучения на его основе. *А. И. Кондрик* 6

Библиография

1 Указатель статей, опубликованных в журнале в 2003 г. 1

в портфеле редакции в портфеле редакции в портфеле редакции в портфеле редакции

- Лазерное текстурирование поверхности монокристалла кремния на температурном пьедестале плавления. (Украина, г. Херсон)
- Монтаж микросборок с подложкой из кремния. (Россия, г. Арзамас)
- Волноводные преобразователи электромагнитной энергии в тепловую. (Украина, г. Одесса)
- Блок детектирования гамма-излучения на основе CdZnTe для систем контроля радиационной обстановки. (Украина, г. Одесса)
- Двухспектральный сенсор дистанционной селекции естественных поверхностей. (Украина, г. Одесса)
- Оптико-электронный дистанционный сенсор с растровой решеткой. (Украина, г. Одесса)
- Нанесение тонких пленок в вакууме на подложки из синтетического опала. (Россия, г. Москва)
- Фотоприемник на основе полевого и однопереходного фототранзисторов. (Украина, г. Одесса)
- Акустоэлектронные сенсоры газа со слоистыми структурами. (Украина, г. Одесса)
- Микроэлектронные термодиодные сенсоры и их применение в экстремальной электронике. (Украина, г. Киев)
- Двухспектральный фотоприемник. (Украина, г. Черновцы)
- Исследование коэффициентов конвективного теплообмена в полупроводниковых термоэлектрических генераторах с каталитическим источником тепла. (Украина, г. Черновцы)
- Теоретическая оценка эффективности принудительного воздушного теплоотвода в рамочных конструкциях БЦВС. (Россия, г. Москва)
- Функциональный генератор колебаний напряжения на КНИ-транзисторе. (Украина, г. Киев)
- Переходные процессы в кремниевых $n^+ - n - n^+$ -резисторах при протекании импульса тока. (Украина, г. Киев)
- Зависимость электрофизических параметров толстопленочных структур "RuO₂—стекло" от дисперсности компонентов и температуры вжигания. (Украина, г. Одесса)
- Оптимизация цифрового фильтра для увеличения глубины резко изображаемого пространства в цифровой оптической микроскопии. (Украина, г. Киев)
- Моделирование сумматоров на языке VERILOG. (Украина, г. Одесса)
- Емкостные свойства МДП-структур HgCdTe/SiO₂—Si₃N₄. (Россия, г. Томск, г. Москва)
 - Деграционные превращения в топологически разупорядоченных твердых телах: 4. Особенности экспоненциальной кинетики. (Украина, г. Львов)
 - Матричный регистр. (Украина, г. Киев)
 - Интегрально-оптические волноводные дисперсионные элементы для ВОЛС. (Россия, г. Москва)
 - Функциональные свойства модифицированных пленок бактериородопсина, перспективного материала для молекулярной электроники. (Россия, г. Москва)

в портфеле редакции в портфеле редакции в портфеле редакции в портфеле редакции

